

**Io=150mA Iq=10μA capacitor-less CMOS LDO Regulator IC**  
**Io=150mA Iq=10μA キャパシタレスCMOS低飽和レギュレータIC**



**TK637XXAB6**  
(FC-4)

**TK637XXH**  
(SON2017-6)

**TK637XXS**  
(SOT23-5)

## DESCRIPTION

The TK637XXAB6 type, the TK637XXH type and the TK637XXS type are CMOS LDO Regulator ICs. The IC offers low quiescent current, and good transient performance.

They are designed for portable applications with space requirements, battery powered system and any electronic equipment.

They do not require a noise-bypass capacitor.

They offer low dropout voltage.

The output voltage is internally fixed from 1.5V to 4.2V.

TK637XXAB6タイプ、TK637XXHタイプ、TK637XXSタイプは、CMOS低飽和レギュレータICです。低い電源電流でありますながら、良好な過渡特性を特長とします。

高密度実装を要求される携帯機器、バッテリ使用機器や一般機器等に最適です。

ノイズパス容量を必要としません。

低い入出力間電圧降下を特長とします。

出力電圧は内部固定で、1.5V ~ 4.2Vで設定可能です。

## FEATURES

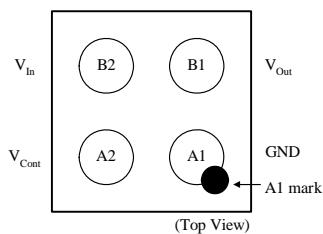
- Package: FC-4 / SON2017-6 / SOT23-5
- No I/O, noise bypass capacitor required
- Low quiescent current
- Good transient performance
- Thermal and over current protection
- On/off control
- High accuracy
- パッケージ: FC-4 / SON2017-6 / SOT23-5
- 入出力・ノイズパス容量が不要
- 低い電源電流
- 良好な過渡特性
- 垂下形過電流保護、過熱保護
- On/offコントロール
- 高い出力電圧精度

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

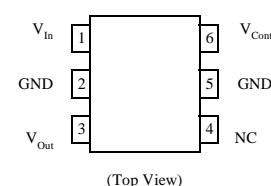
Type	V <sub>OUT</sub> (tolerance)	I <sub>OUT</sub> (I <sub>OUT,MAX</sub> )	On/off control	V <sub>DROP</sub> @I <sub>OUT</sub>	I <sub>Q</sub> @I <sub>O</sub> =0mA	Ripple rejection	V <sub>OP</sub>	T <sub>OP</sub>	P <sub>D</sub>	f <sub>OP</sub>
TK637XXAB6	1.5 to 4.2V (±2.0% or ±60mV)	150mA (200mA)	Active high	80mV (@50mA)	10μA	-65dB @f=1kHz	1.8 to 6.0V	-40 to +85°C	360mW	-
TK637XXH	1.5 to 4.2V (±2.0% or ±60mV)	150mA (200mA)	Active high	90mV (@50mA)	10μA	-65dB @f=1kHz	1.8 to 6.0V	-40 to +85°C	500mW	-
TK637XXS	1.5 to 4.2V (±2.0% or ±60mV)	150mA (200mA)	Active high	90mV (@50mA)	10μA	-65dB @f=1kHz	1.8 to 6.0V	-40 to +85°C	500mW	-

## PIN DESCRIPTION

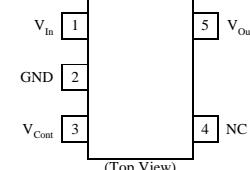
■ TK637XXAB6



■ TK637XXH



■ TK637XXS



## BLOCK DIAGRAM

